

ПРОТОКОЛ № 11

заседания диссертационного совета ФТИ 34.01.02
при Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

от 19 декабря 2024 г.

Присутствовали члены совета: Бурков А.Т., Ивченко Е.Л., Глазов М.М., Сорокин Л.М., Аверкиев Н.С., Арсентьев И.Н., Бобыль А.В., Векслер М.И., Горбатюк А.В. (удаленно), Гуревич С.А., Зегря Г.Г., Копьев П.С., Лебедев А.А., Левинштейн М.Е., Парфеньев Р.В. (удаленно), Тарасенко С.А., Фирсов Д.А. (удаленно), Яковлев Ю.П.

Всего присутствовало 18 из 23 членов совета.

Председатель: академик РАН Ивченко Е.Л.

Слушали:

I.

Прием к защите диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических наук.

Специальность 1.3.11 – «физика полупроводников».

Тема диссертации: «Электронные состояния и нелинейный транспорт в двумерных дираковских материалах».

Соискатель: Дурнев Михаил Васильевич.

Предложены оппоненты:

1. Фирсов Дмитрий Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2. Бурмистров Игорь Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук, заместитель директора,
3. Мельников Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, Институт физики микроструктур РАН, заведующий отделом физики сверхпроводников.

Предложена ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук.

Докладчик: д.ф.-м.н. Тарасенко С.А.

Комиссия в составе: Аверкиев Н.С., Зегря Г.Г., Шубина Т.В. дала положительное заключение по диссертации.

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию Дурнева Михаила Васильевича «Электронные состояния и нелинейный транспорт в двумерных дираковских материалах».
2. Утвердить оппонентов и ведущую организацию;
3. Разместить полный текст диссертации и автореферата на сайте института;
4. Утвердить список учреждений и лиц для рассылки автореферата;
5. Назначить дату защиты – 27 марта 2025 г. в 11:00;
6. Разрешить печать автореферата.

Решение принято открытым голосованием: «за» - 18, «против» - 0.

II.

Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

Специальность 1.3.11 – «физика полупроводников».

Тема диссертации: «Физические и конструктивно-технологические решения по созданию высоковольтных и лавинных 4H-SiC диодов»

Соискатель: Лебедева Наталья Михайловна

Научный руководитель:

Иванов Павел Анатольевич, доктор физико-математических наук, Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки «Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН», ведущий научный сотрудник лаборатории мощных полупроводниковых приборов.

Консультант:

Левинштейн Михаил Ефимович, доктор физико-математических наук, профессор, Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки «Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН», главный научный сотрудник лаборатории физики полупроводниковых приборов.

Предложены оппоненты:

1. Векслер Михаил Исаакович, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук, Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки «Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН» главный научный сотрудник, заведующий лабораторией мощных полупроводниковых приборов,
2. Афанасьев Алексей Валентинович, кандидат технических наук, доцент кафедры микро- и нанoeлектроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ведущий научный

сотрудник Инжинирингового центра микротехнологии и диагностики (ИЦ ЦМИД).

Предложена ведущая организация:

АО «Группа «КРЕМНИЙ-ЭЛ», 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103.

Докладчик: д.ф.-м.н. Лебедев А.А.

По результатам рассмотрения диссертации комиссия диссертационного совета в составе: д.ф.-м.н. Лебедев А.А., д.ф.-м.н. Векслер М.И., д.ф.-м.н. Арсентьев И.Н. дала положительное заключение по диссертации.

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию Лебедевой Натальи Михайловны «Физические и конструктивно-технологические решения по созданию высоковольтных и лавинных 4H-SiC диодов»;
2. Утвердить оппонентов и ведущую организацию;
3. Разместить полный текст диссертации и автореферата на сайте института;
4. Утвердить список учреждений и лиц для рассылки автореферата;
5. Назначить дату защиты – 17 апреля 2025 г., 11:00;
6. Разрешить печать автореферата.

Решение принято открытым голосованием: «за» - 18, «против» - 0.

Председатель Совета
академик РАН

Ивченко Е.Л.

Ученый секретарь
д.ф.-м.н.

Сорокин Л.М.